1과목 : 전기자기학

- 1. 다음 중 표피효과 설명으로 옳은 것은?
 - 주파수가 높을수록 침투깊이가 얇아진다.
 - ② 표피효과에 따른 표피저항은 단면적에 비례한다.
 - ③ 투자율이 크면 표피효과가 작게 나타난다.
 - ④ 도전율이 큰 도체에는 표피효과가 적게 나타난다.
- 2. 다음 중 반자성체에 속하는 것은?
 - ① 철
- ② 니켈
- ③ 알루미늄
- 4 구리
- 3. 공기 중에 반지름 r[m]의 매우 긴 평행 왕복도체가 d[m]의 간격으로 놓여있을 때 단위 길이당의 정전용량은 몇 [F/m] 인가? (단, r < d 이다.)

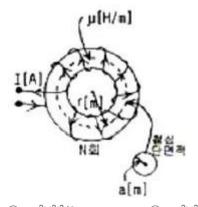
$$\frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{d}{r}}$$

$$\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\frac{d}{r}}$$

$$2\pi\epsilon_0 \ln \frac{d}{r}$$

$$\frac{1}{4} \ln \frac{r}{d}$$

- 4. 공기 중에서 5[V], 10[V]로 대전된 반지름 2[cm], 4[cm]의 2개의 구를 가는 철사로 접속했을 때 공통 전위는 몇 [V] 인가?
 - ① 6.25
- 2 7.5
- **3** 8.33
- 4 10
- 5. 그림과 같은 환상 철심코일의 코일내에 저축된 자기에너지는 몇 [J] 인가?



- ① $\mu a^2 N^2 I^2 / 2\pi r$
- ② $\mu a^2 N^2 I^2 / 4\pi r$
- $3 \mu a^2 N^2 I^2 / 2r$
- **4** $\mu a^2 N^2 I^2 / 4 r$
- 6. 다음 식 중 옳지 않은 것은?

$$_{\odot}$$
 $V_{p} = \int_{0}^{\infty} E \cdot d\ell$

② E = -grad V

grad
$$V = i \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + k \frac{\partial V}{\partial z}$$

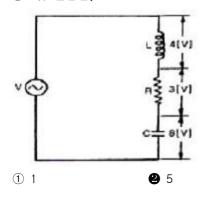
$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{Q}$$

- 7. 정전 용량이 0.03[µF]의 평행판 공기콘덴서에 전극 간격의 1/2두께의 유리판을 전극에 평행하게 넣으면 정전용량은 약 몇 [µF] 인가? (단, 유리판의 비유전율은 10 이라 한다.)
 - ① 0.005
- 2 0.015
- **6** 0.055
- ④ 0.155
- 8. 공기 중에서 전자기파의 파장이 3[m]라면 그 주파수는 몇 [MHz] 인가?
 - **1** 100
- ② 300
- 3 1000
- 4 3000
- 9. 반지름 a[m]의 구 도체에 전하 Q[C]이 주어질 때 구도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 [N/m²] 인가?
 - ① $9Q^2/16\pi\epsilon_o a^6$
- ② $9Q^2/32\pi\epsilon_0 a^6$
- (3) Q²/16πε_οa⁴
- $\mathbf{Q}^2/32\pi\epsilon_0 \mathbf{a}^4$
- 10. 직렬로 접속한 2개의 코일에 있어서 합성 자기 인덕턴스는 80[mH]가 되고 한쪽 코일의 접속을 반대로 하면 합성 자기 인덕턴스는 50[mH]가 된다. 두 코일사이의 상호 인덕턴스는 몇 [mH] 인가?
 - ① 2.5
- 2 6.0
- **6** 7.5
- 4 9.0
- 11. 전기회로에서 도전율[♡/m]에 대응하는 것은 자기회로에서 어떤 것인가?
 - ① 자속
- ② 기자력
- 육 투자율
- ④ 자기저항
- 12. 순수한 물의 비투자율 μ_r = 1, 비유전율 ε_r = 78 이다. 여기 에 300[MHz]의 전파를 보냈을 때 전파속도는 몇 [m/s] 인 가?
 - 1 3.40×10^7
- $2.3.40 \times 10^6$
- \bigcirc 2.41×10⁷
- 4 2.41×10⁵
- 13. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 전기력선의 방정식은 "전기력선의 접선방향이 전계의 방향이다."에서 유래된 것이다.
 - ② "전기력선은 스스로 루프(loop)를 만들 수 없다."라 함은 전계의 세기의 유일성을 나타내는 것이다.
 - ③ 구좌표로 표시한 전기력선의 방정식은 dr/E_r = rdθ/E_θ = rcosθdθ/E_θ로 표시된다.
 - ④ 진공 중에서 1[C]의 점전하로부터 발산되어 나오는 전 기력선의 수는 1.13×10¹¹개 이다.
- 14. 저항 R에 전압 V를 인가하였을 때 발생하는 열량을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 - ❶ 저항 R의 제곱에 반비례한다.
 - ② 인가한 전압 V의 제곱에 비례한다.
 - ③ 전압을 가한 시간에 비례한다.
 - ④ 저항에 흐르는 전류의 제곱에 비례한다.
- 15. 10[cm³]의 체적에 3[μC/cm³]의 체적전하분포가 있을 때, 이 체적 전체에서 발산하는 전속은 몇 [C] 인가?
 - ① 3×10^5
- (2) 3×10⁶

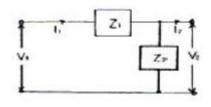
- 3×10^{-5}
- (4) 3×10⁻⁶
- 16. 환상 철심에 감은 코일에 5[A]의 전류를 흘려 2000[AT]의 기자력을 생기게 하려면 코일의 권수(회)는 얼마로 하여야 하는가?
 - 1 10000
- 2 500
- **3** 400
- 4 250
- 17. 자유공간에서 맥스웰의 전자파에 관한 기본 방정식은?
 - ① rotH = i, rotE = $-\partial B/\partial t$
 - ② rotH = $\partial D/\partial t$, rotE = $\partial B/\partial t$
 - 3 rotH = $\partial D/\partial t$, rotE = $-\partial B/\partial t$
 - 4 rotH = i, rotE = $\partial B/\partial t$
- 18. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 유전체의 전속밀도는 도체에 준 진전하 밀도와 같다.
 - ② 유전체의 전속밀도는 유전체의 분극전하 밀도와 같다.
 - ③ 유전체의 분극선의 방향은 -분극전하에서 +분극전하로 향하는 방향이다.
 - ④ 유전체의 분극도는 분극전하 밀도와 같다.
- 19. 전기쌍극자에 의한 전계의 세기는 쌍극자로부터의 거리 r에 대해서 어떠한가?
 - ① r 에 반비례한다.
- ② r²에 반비례한다.
- **3** r³에 반비례한다.
- ④ r⁴에 반비례한다.
- 20. 폐곡면을 통하는 전속과 폐곡면 내부의 전하와의 상관관계 를 나타내는 법칙은?
 - 1 가우스의 법칙
- ② 쿨롱의 법칙
- ③ 포아송의 법칙
- ④ 라프라스의 법칙

2과목: 회로이론

- 21. 다음 중 정현파(전파)의 파고율은?
 - 1 1
- $\sqrt{3}$
- 22. 전압 50[V], 전류 10[A]로서 400[W]의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 몇 [Ω] 인가?
 - **0** 3
- 2 4
- 3 5
- (4) 8
- 23. 그림과 같은 회로에서 전압 V는 몇 [V] 인가? (단, V는 단 상교류 전압임)



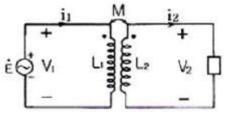
- ③ 7
- 4) 15
- 24. 다음 그림과 같은 4단자 회로망에서 4단자 정수는?



- Z_1
- 1
- 25. 다음은 정현파를 대표하는 phasor이다. 정형파를 순시치로 나타내면?

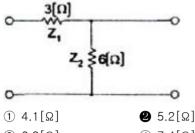
$$E = 10e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

- $10\sqrt{2}\sin\left[\omega t + \frac{\pi}{3}\right]$ 2 $10\sin\left[\omega t + \frac{\pi}{3}\right]$
- $10\sqrt{2}\sin\left[\omega t-\frac{\pi}{3}\right]$
- $_{\text{\tiny 4}}$ 10sin ωt –
- 26. 그림은 이상적 변압기이다. 성립되지 않는 관계식은? (단, n₁, n₂는 1차 및 2차 코일의 권회수, n = n₁/n₂이다.)



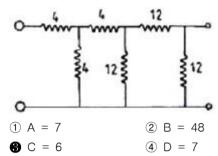
- ① $V_1/V_2 = n_1/n_2$
- ② $V_1i_1 = V_2i_2$
- $3i_1/i_2 = n_2/n_1$
- 27. 단위 계단함수 U(t)와 지수 e^{-t}의 컨볼루션 적분은?
 - (1) e^{-t}
- (2) 1/e^{-t}
- **8** 1-e^{-t}
- $4 1 + e^{-t}$
- 28. 100[V], 30[W]의 형광등에 100[V]를 가했을 때, 0.5[A]의 전류가 흐르고 그 소비전력은 20[W]이었다면 이 형광등의 역률은?
 - 0.4
- 2 0.5
- 3 0.6
- 4 0.8

29. 다음 회로의 영상 임피던스 Z₀₁은 약 얼마인가?

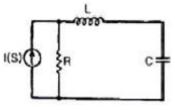


- ③ $6.3[\Omega]$
- (4) $7.4[\Omega]$

30. 다음 회로망은 T형 회로 및 π형 회로의 종속 접속으로 이루 어졌다. 이 회로망의 ABCD parameter 중 옳지 않은 것은?

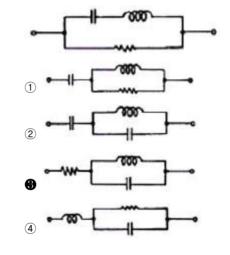


- 31. 이상적인 변압기의 조건으로 옳은 것은?
 - 코일에 관계되는 손실이 없이, 두 코일의 결합계수가 1 인 경우
 - ② 상호 자속이 전혀 없는 경우, 즉 유도 결합이 없는 경우
 - ③ 상호 자속과 누설 자속이 전혀 없는 경우
 - ④ 결합 계수 K가 O인 경우
- 32. RL 직렬회로에 t = 0일 때. 직류 전압 100[V]를 인가하면 흐르는 전류 i(t)는? (단, R = 50[Ω], L = 10[H]이다.)
 - ① $2(1-e_{5t})$
- $2(1-e_{-5t})$
- 3 1.96(1-e_{t/5})
- $4 1.96(1-e_{-t/5})$
- 33. 저항 1개와 커패시터 1개를 직렬 연결하여 R-C의 직렬회로 를 구성하고, 일정한 정현파 전압을 인가하였다. 이 때 커패 시터의 양단에서의 전압위상과 저항에 흐르는 전류의 위상 을 비교하였을 때의 위상차는?
 - (1) 45°
- **2** 90°
- ③ 135°
- (4) 180°
- 34. K의 비례요소가 존재하는 회로의 전달함수는?
 - **0** K
- 2 K/s
- ③ 1/K
- (4) sK
- 35. 다음 회로에서 커패시터에 걸리는 전압을 구하면?

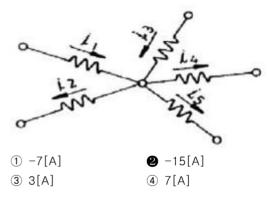


- ① V(S) = I(S)/(SL+R)SC+1
- 2 V(S) = I(S)R/(SL+R)SC+1
- (3) V(S) = I(S)/(SL+R)+1

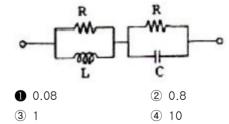
- (4) V(S) = I(S)R/(SL+R)SC
- 36. 기본파의 50[%]인 제3고조파와 30[%]인 제5고조파를 포함 하는 전압파의 왜형률은 약 얼마인가?
 - (1) 0.2
- (2) 0 4
- **3** 0.6
- 4 0.8
- 37. 다음 그림과 쌍대가 되는 회로는?



38. 다음 그림에서 i₁ = 16[A], i₂ = 22[A], i₃ = 18[A], i₄ = 27[A]일 때 i₅는?



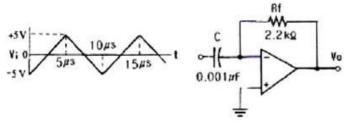
39. 그림의 회로가 정저항 회로가 되려면 L은 몇 [H] 인가? (단, R = 20[Ω], C = 200[μF]이다.)



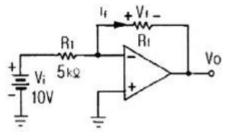
- 40. 상수 1의 라플라스 역변환은?
 - ① $\mu(t)$
- (2) t
- **3** δ(t)
- 4 r(t)

3과목: 전자회로

41. 다음과 같이 미분 연산증폭기에 삼각파 입력이 공급될 때, 출력전압의 범위는?

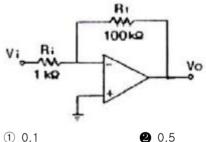


- ① $-3.3[V] \sim +3.3[V]$
- **2** $-4.4[V] \sim +4.4[V]$
- (3) -5.5[V] \sim +5.5[V]
- (4) $-6.6[V] \sim +6.6[V]$
- 42. I_{DSS} = 25[mA], V_{GS(off)} = 15[V]인 P 채널 JFET가 자기바이 어스 되는데 필요한 R_s 값은 약 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, V_{GS}=5[V]이다.)
 - (1) $100[\Omega]$
- ② 270[Ω]
- **3** 450[Ω]
- (4) $510[\Omega]$
- 43. 다음 연산증폭기 회로에서 저항 Rf 양단에 걸리는 전압 Vf = $(25 I_f^2 + 50 I_f + 3)[V]$ 의 관계가 있을 때 출력 전압 V_o 는 몇 [V] 인가?



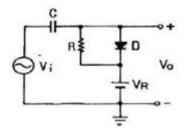
- (1) -3[V]
- 2 -3.2[V]
- (3) -4.1[V]
- (4) -5.8[V]
- 44. FM 변조 방식에서 변조지수가 6 이고, 신호 주파수가 10[kHz]일 때 점유주파수 대역폭은 몇 [kHz] 인가?
 - ① 60[kHz]
- ② 70[kHz]
- ③ 120[kHz]
- **1** 140[kHz]
- 45. 고역 차단주파수가 500[kHz]인 증폭회로를 2단으로 종속 연결했을 때 종합 고역 차단주파수는 약 몇 [kHz]인가?
 - ① 120[kHz]
- 2 240[kHz]
- **3**20[kHz]
- 4 500[kHz]
- 46. 다음 중 BJT와 비교한 FET의 특성에 대한 설명으로 적합하 지 않은 것은?
 - ❶ 전류제어형이다.
 - ② 잡음특성이 양호하다.
 - ③ 이득대역폭적이 작다.
 - ④ 온도 변화에 따른 안정성이 높다.
- 47. 다음 중 수정발진기에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 압전 효과를 이용한다.
 - ② 발진 주파수의 안정도가 매우 높다.
 - ③ 수정편이 컷 방법에 따라 온도 계수가 달라진다.
 - ♪ 수정편이 같은 두께일 때 X 컷 보다 Y 컷의 발진주파수 가 높다.
- 48. 다음 중 베이스 접지 증폭회로에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 고주파수 특성이 양호하다.

- ② 입출력 위상은 동위상이다.
- ③ 입력저항은 수십[Ω] 정도로 작다.
- ♪ 전류 증폭도가 수십 ~ 수백으로 크다.
- 49. 어떤 차동증폭기의 동상신호제거비(CMRR)가 50[dB]이고 차동이득(Ad)이 1000일 때 동상이득 (Ac)은 얼마인가?
 - **1** 0 1
- 2 1
- ③ 10
- (4) 12.5
- 50. 다음 연산증폭기 회로에서 출력임피던스는 약 몇 [Ω]인가? (단, 개루프 전압증폭도 A는 10000 이고, 출력임피던스는 50[요]이다.)

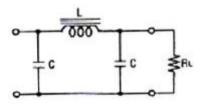


- 3 1.0
- 4 5.0
- 51. 변조도가 100[%]인 DSB 파의 전력이 30[kW]이라면 반송 파 성분의 전력은 몇 [kW] 인가?
 - ① 10[kW]
- **2** 20[kW]
- 3 30[kW]
- 45[kW]
- 52. 다음 중 트랜스 결합 증폭회로에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - 1 주파수 특성이 매우 평탄하다.
 - ② 전압손실이 거의 없어 전원 효율이 좋다.
 - ③ 트랜스의 성능을 좋게 하기 위해서는 크기가 대형이고 값이 비싸다.
 - ④ 트랜스 결합 증폭회로는 임피던스 정합이 용이하여 주로 전력증폭용으로 사용된다.
- 53. α가 0.98이고, α 차단 주파수가 2000[kHz]인 트랜지스터를 이미터 접지로 사용할 경우 β 차단 주파수는 몇 [kHz] 인 가?
 - ① 20[kHz]
- 2 30[kHz]
- **6** 40[kHz]
- 4 50[kHz]
- 54. fr(단위 이득 주파수)가 175[MHz]인 트랜지스터가 중간 영 역에서 전압이득이 50인 증폭기로 사용될 때 이상적으로 이 룰 수 있는 대역폭은 몇 [MHz] 인가?
 - ① 2.7[MHz]
- **2** 3.5[MHz]
- ③ 5.2[MHz]
- 4 25.4[MHz]
- 55. 트랜지스터 컬렉터 누설 전류가 주위 온도 변화로 1.2[µA] 에서 121.2[µA]로 증가되었을 때 컬렉터 전류는 12[mA]에 서 12.6[mA]로 변화하였다면 안정계수는 얼마인가?
 - (1) 3.2
- **2** 5.0
- 3 6.5
- 4 8.3
- 56. 어떤 증폭기에서 궤환이 없을 때 전압이득이 60[dB]이다. 궤환 시의 전압 궤환율(β)이 0.01일 때 전압이득은 약 몇 [dB] 인가?

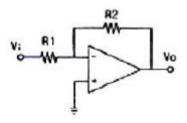
- ① 30[dB]
- **2** 40[dB]
- ③ 50[dB]
- 4 60[dB]
- 57. 다음 중 트랜지스터 증폭기에서 온도 변화에 따른 동작점 (Q)의 변동 원인에 영향이 가장 적은 것은?
 - ① β값의 변화
- ② V_{BE}값의 변화
- ③ 100값의 변화
- 4 동작 주파수 값의 변화
- 58. 다음 회로의 동작에 대한 설명으로 가장 적합한 것은? (단, 입력신호는 진폭이 Vm인 정현파이고, 다이오드는 이상적인 것이며, RC 시정수는 신호파의 주기에 비해 매우 크다.)



- ① 출력은 V_i 이다.
- ② 출력은 2V_i 이다.
- ❸ 출력전압은 V_R-V_m인 정현파이다.
- ④ 부방향 peak를 기준레벨 V_R 로 클램프 한다.
- 59. 다음 회로에서 리플 함유율을 작게 하는 방법으로 적합하지 않은 것은?



- ① L을 크게 한다.
- ② C를 크게 한다.
- ❸ R∟을 적게 한다.
- ④ 교류입력 전원의 주파수를 높게 한다.
- 60. 다음 연산증폭기 회로에서 R₁ = 10[kΩ], R₂ = 100[kΩ] 일 때 궤환율(β)은 약 얼마인가?



- 1 0.01
- **2** 0.09
- ③ 0.12
- **4** 0.9

4과목: 물리전자공학

- 61. 300[°K]에서 Fermi 준위 E_f 보다 0.1[eV] 낮은 에너지 (Energy) 준위에 전자가 점유할 확률은 약 몇 [%] 인가?
 - **1** 98[%]
- ② 88[%]
- ③ 78[%]
- 4 68[%]

- 62. 반도체에 전계를 가하면 정공의 드리프트(drift) 속도의 방향은 어떻게 되는가?
 - ❶ 전계와 같은 방향이다.
 - ② 전계와 반대 방향이다.
 - ③ 전계와 직각 방향이다.
 - ④ 전계와 무관한 지그재그 운동을 한다.
- 63. 다음 중 반도체 내의 캐리어의 이동도(μ)와 확산 계수 (D) 사이의 관계가 바르게 된 것은?
- ② $\mu/D = kT/e$
- 3D = kT/e
- 4 D/ μ = 1/kTe
- 64. 전자가 외부의 힘(열, 빛, 전장을) 받아 핵의 구속력으로부 터 벗어나 결정 내를 자유로이 이동할 수 있는 자유전자의 상태로 존재하는 에너지대는?
 - ① 충안대(filled band)
 - ② 급지대(forbidden band)
 - ③ 가전자대(valence band)
 - ♠ 전도대(conduction band)
- 65. 일반적으로 순수(intrinsic) 반도체에서 온도의 상승으로 나타나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 반도체의 저항이 증가한다.
 - ② 정공이 전도대로 이전한다.
 - 3 원자의 에너지가 증가한다.
 - ④ 원자의 에노지가 감소한다.
- 66. 억셉터 불순물로 사용되는 원소가 아닌 것은?
 - ① 갈륨(Ga)
- ② 인듐(In)
- **3** 비소(As)
- ④ 붕소(B)
- 67. 다음 중 플라즈마(Plasma)와 같은 기체 상태의 경우 적용될 수 있는 분포식은?
 - ① Einstein의 관계식
 - 2 Maxwell-Boltzmann
 - ③ Schro dinger 방정식
 - ④ 1차원의 Poisson 방정식
- 68. 다음 중 물질에서 전자가 방출할 수 있는 조건으로 적당하 지 않은 것은?
 - ① 열을 가한다.
- ② 빛을 가한다.
- ③ 전계를 가한다.
- 4 압축한다.
- 69. 마치 3극관이 음극에서 양극에 향하는 전자류를 격자에 의하여 제어하듯이 N형(또는 P형) 반도체 내의 전자(정공)의 흐름을 제어하는 것은?
 - ① TRIAC(트라이맥)
 - 2 FET(Field Effect Transistor)
 - 3 SCR(Silicon Controlled Rectifier)
 - 4 UJT(UniJunction Junction Transistor)
- 70. 페르미 준위에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 불순물의 양과 온도가 증가할수록 금지대의 중앙으로부터 멀어진다.
 - ② 불순물의 양과 온도가 증가할수록 진성반도체의 페르미

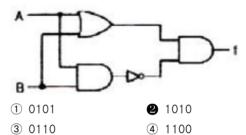
준위에 가까워진다.

- 불순물의 양이 증가하면 금지대의 중앙으로부터 멀어지 고, 온도가 증가하면 그와 반대이다.
- ④ 불순물의 양이 증가하면 금지대의 중앙으로 가까워지고. 온도가 증가하면 그와 반대이다.
- 71. 드브로이(de Broglie) 물질파의 개념으로 볼 때 전자파의 파 장이 무한대일 경우 전자의 상태는?
 - 1 정지상태
- ② 직선운동
- ③ 나선운동
- ④ 원운동
- 72. 다음 중 열평형 상태에서 있는 반도체에서 정공(正孔) 밀도 p와 전자밀도 n을 곱한 pn적에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 온도 및 불순물 밀도의 함수이다.
 - ② 온도 및 금지대 에너지 폭의 함수이다.
 - ❸ 불순물 밀도 및 Fermi 준위의 함수이다.
 - ④ 불순물 밀도 및 금지대 에너지 폭의 함수이다.
- 73. PN 접합의 역전압 의존성을 이용한 소자는?
 - ① Tunnel 다이오드
- ② Zener 다이오드
- ③ Varistor
- 4 Varactor 다이오드
- 74. 트랜지스터 증폭기에서 부하 저항이 클수록 전류 이득은?
 - ① 변함없다.
 - 2 감소한다.
 - ③ 증가한다.
 - ④ 베이스 접지에서만 증가하고. 에미터 접지나 컬렉터 접 지에서는 감소한다.
- 75. 다음 중 얼리(Early) 효과와 관계되는 것은?
 - ① 항복 현상
- ② 이미터의 효율
- 에 베이스 폭의 감소
- ④ 역바이어스 전압
- 76. 1[Couloeb]의 전하량은 전자 몇 개가 필요한가? (단, e = 1.602×10⁻¹⁹[C])
 - ① 6.24×10^{15}
- 2 6.24×10¹⁸
- 36.24×10^{20}
- (4) 6.24×10²²
- 77. 서로 다른 도체로 폐회로를 구성하고 직류 전류를 흐르게 하면, 전류의 방향에 따라 서로 다른 도체 사이의 접합의 한쪽은 가열되는 반면, 또 다른 한쪽은 냉각이 되는 효과를 무엇이라 하는가?
 - Peltier Effect
- 2 Seebeck Effect
- 3 Zeeman Effect
- 4 Hall Effect
- 78. 접합형 트랜지스터의 구조를 올바르게 설명한 것은?
 - ① 이미터, 베이스, 컬렉터의 폭은 거의 비슷한 정도로 한 다.
 - ② 불순물 농도는 이미터를 가장 크게, 컬렉터를 가장 적게 한다.
 - ❸ 베이스 폭은 비교적 좁게 하고, 불순물은 적게 넣는다.
 - ④ 베이스 폭은 비교적 좁게 하고, 불순물은 많이 넣는다.
- 79. 진성 반도체에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - 반도체의 저항 온도계수는 양(+)이다.
 - ② 운반체(carrier)의 밀도는 온도가 상승하면 증가한다.

- ③ Fermi 준위는 어떤 온도에서든지 전도대와 가전자대의 중앙에 위치한다.
- ④ 단위 체적당 전도대 중의 전자의 수와 단위 체적당 가전 자대 중의 정공의 수는 같다.
- 80. 빛의 파동성을 입증할 수 있는 근거는?
 - ① 산란현상
- 2 회절현상
- ③ 광전현상
- ④ 콤프턴(compton) 효과

5과목: 전자계산기일반

- 81. CPU가 명령어를 실행할 때의 메이저 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 실행 사이클은 간접주소 방식의 경우에만 수행된다.
 - ② 명령어의 종류를 판별하는 것을 간접 사이클이라 한다.
 - ❸ 기억장치내의 명령어를 CPU로 가져오는 것을 인출사이 클이라 한다.
 - ④ 인터럽트 사이클 동안 데이터를 기억장치에서 읽어낸다.
- 82. 다음 회로에서 A = 1011. B = 0111 이 입력되어 있을 때 그 출력은?



- 83. 메모리 장치와 주변 장치 사이에서 데이터의 입・출력 정송 이 직접 이루어지는 것은?
 - 1 MIMD
- ② UART
- ③ MIPS
- 4 DMA
- 84. 다음은 언팩 10진 형식으로 표기한 것이다. 이를 10진수로 옳게 표현한 것은?

1111	0011	1111	1001	1100	0101
1 +9125	5	(2)	9125		
3 +395		<u>(4</u>			

- 85. 프로그램이 수행될 때 최근에 사용한 인스트럭션과 데이터 를 다시 사용할 가능성이 크다는 것을 무엇이라 하는가?
 - 1 접근의 국부성
- ② 디스크인터리빙
- ③ 페이징
- ④ 블록킹
- 86. 직렬 시프트 레지스터(4bit)에 1011 이 현재 들어있고 이 직 렬 레지스터가 0110을 삽입하려면 몇 개의 클럭펄스가 필요 한가?
 - 1) 11
- 2 6
- 3 5
- **4**
- 87. 다음 중 홀수 패리티 발생기에 대한 식으로 옳은 것은? (단, 입력은 x, y, z이다.)
 - ① (x ⊙ y) ⊙ z
- ② $(x \oplus y) \oplus z$
- ④ (x+y) ⋅ z

88. 운영체제(OS)에서 제어 프로그램에 속하지 않는 것은?

- ① 감시 프로그램
- ② 작업 관리 프로그램
- ③ 데이터 관리 프로그램
- 4 언어 번역 프로그램

89. 64k인 주소공간과 4K인 기억공간을 가진 컴퓨터의 경우, 한 페이지(page)가 512워드로 구성된다면 페이지와 블록 수는 각각 얼마인가?

① 페이지: 16. 블록: 12 ② 페이지: 16, 블록: 16 ③ 페이지: 128, 블록: 8 ④ 페이지: 128, 블록: 16

90. 번지를 기억하고 있는 레지스터와 관계없는 것은?

① MAR

2 IR

(3) PC

(4) SP

91. 캐시 메모리와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 연관매핑(associative mappint)
- ② 가상기억장치(virtual memory)
- ③ 적중률(hit ratio)
- ④ 참조의 국한성(locality of reference)

92. 디스크에 헤드가 가까울수록 불순물이나 결함에 의한 오류 발생의 위험이 더 크다. 이러한 문제점을 해결한 것은?

- ❶ 윈체스터 디스크
- ② 이동 디스크
- ③ 콤팩트 디스크
- ④ 플로피 디스크

93. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 레지스터는 데이터를 일시적으로 기억하는 장치로 기능 에 따라 여러 가지 이름이 붙여진다.
- ② 프로그래머는 연산용 레지스터에 기억된 내용을 프로그 램을 통해 직접적으로 변경할 수 없다.
- ③ 명령 레지스터는 실행 중에 있는 명령을 기억하고 주소 를 보관하는 레지스터로서 명령부와 주소부로 구성되어 있다
- ④ 명령해독기는 AND 논리회로의 집합으로 구성되어 있다.

94. 변수에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ❶ 프로그램 내에서 자료를 기억시킬 수 있는 기억장소
- ② 하드디스크 내에 자료를 기억시킬 수 있는 공간
- ③ 프로그램 실행과정에서 변하지 않는 값을 저장
- ④ 프로그램 실행과정에서 프로그램이 중단되더라도 손실되 지 않는다.

95. 10진수 13을 그레이 코드(Grav code)로 변환하면?

① 1001

2 0100

3 1100

4 1011

96. 서브루틴(subroutine) 호출 처리 작업시 복귀주소를 저장하 고 조회하는 용도에 적합한 자료 구조는?

① 업

② 큐

❸ 스택

④ 연결 리스트

97. memory-mapped I/O 방식의 사용상 특징은?

● 메모리와 입·출력 번지 사이의 구별이 없다.

- ② 입・출 전용 번지가 할당되기 때문에 프로그램의 이해 및 작성이 쉽다.
- ③ 기억장치의 이용효율이 높다.
- ④ 하드웨어가 복잡하다.

98. 반도체 메모리 소자 중 SRAM의 특징이 아닌 것은?

- ① 플립플롭에 의한 기억소자로 내부힜로가 복잡하다.
- ② DRAM에 비해서 고집적도가 용이하고 소비전력이 많다.
- ③ 읽기, 쓰기의 고속 실행이 가능하다.
- ④ refresh 회로가 필요 없다.

99. 단항(unary) 연산에 속하지 않는 것은?

- ① MOVE 연산
- ② Complement 연산
- ③ Shift 연산
- 4 OR 연산

100. 주소지정방식(addressing mode)에서 오퍼랜드(operand) 부분에 데이터가 포함되어 실행되는 방식은?

- 1 index addressing mode
- 2 direct addressing mode
- 3 indirect addressing mode
- Immediate addressing mode

전자문제집 CBT PC 버전: www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전: m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 LICE

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	1	3	4	4	3	1	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	3	1	3	3	3	2	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	2	1	3	4	3	1	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	2	1	2	3	3	2	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	2	4	3	1	4	4	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	3	2	2	2	4	3	3	2
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	1	1	4	3	3	2	4	2	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	3	4	2	3	2	1	3	1	2
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
3	2	4	3	1	4	3	4	3	2
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	1	2	1	4	3	1	2	4	4